

	<p>SIB419DK-T1-GE3</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SIB419DK-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 12V 9A SC75-6</p> <p>Datenblätter:  SIB419DK-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIB419DK-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 12V 9A SC75-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SC-75-6L Single
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	60 mOhm @ 5.2A, 4.5V
Verlustleistung (max)	2.45W (Ta), 13.1W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SC-75-6L
Andere Namen	SIB419DK-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	562pF @ 6V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11.82nC @ 5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 12V 9A (Tc) 2.45W (Ta), 13.1W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Tc)

SIB419DK-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIB419DK-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIB419DK-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIB419DK-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIB422EDK-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 9A SC-75-6</p>	 <p>SIB433EDK-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 9A SC-75-6</p>	 <p>SIB419DK-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 12V 9A SC75-6</p>	 <p>SIB422EDK-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 9A SC-75-6</p>
 <p>SIB417DK-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 8V 9A SC75-6</p>		 <p>SIB417DK-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 8V 9A SC75-6</p>	 <p>SIB417EDK-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 8V 9A SC75-6</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIB419DK-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIB419DK-T1-GE3 Datenblatt	SIB419DK-T1-GE3-Datenblätter	SIB419DK-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIB419DK-T1-GE3
SIB419DK-T1-GE3 Electronic	SIB419DK-T1-GE3-Komponenten	SIB419DK-T1-GE3-Verteiler	SIB419DK-T1-GE3-Bild	SIB419DK-T1-GE3-Teil
SIB419DK-T1-GE3 Preis	SIB419DK-T1-GE3 Hersteller	SIB419DK-T1-GE3 Bild	SIB419DK-T1-GE3 Aktie	SIB419DK-T1-GE3 Inventar
SIB419DK-T1-GE3 Neu	SIB419DK-T1-GE3 Original	SIB419DK-T1-GE3 garantiert	SIB419DK-T1-GE3 RFQ	SIB419DK-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited